

УДК 621.315  
 © 1992

## ДИСКРЕТНЫЕ И КВАЗИДИСКРЕТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ДОНОРОВ В Ge В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

*A. M. Палкин, О. А. Шегай*

Методом субмиллиметровой лазерной магнитоспектроскопии (СММ Л МС) исследовались примесные состояния мелких доноров фосфора (P) и сурьмы (Sb), возникающих на фоне непрерывного континуума под уровнями Ландау с номером  $N > 1$ . В спектре возбужденных дискретных состояний P обнаружены переходы  $1s - np^+$  вплоть до  $n = 13$ . Использование циркулярно-поляризованного излучения лазера позволило провести идентификацию возбужденных состояний по проекции момента при переходе с основного состояния примеси как P, так и Sb. Обнаружено, что для  $N > 2$  возникает серия возбужденных состояний, идентифицированных как  $(Nl\nu)$  и  $(N\bar{l}\nu)$ .

Последнее время большой интерес вызывают исследования примесного спектра, возникающего в магнитном поле на фоне непрерывного континуума (см., например, для  $n$ -GaAs [1–3],  $p$ -Ge [4, 5]). При этом необходимо различать исчезающие при уменьшении магнитного поля квазидискретные (метастабильные) состояния и переходящие в возбужденные состояния зеемановского расщепления дискретные (стабильные) состояния.

Известно, что в большом магнитном поле примесные состояния описываются набором квантовых чисел  $(Nm\nu)$ , где  $m$  — магнитное квантовое число,  $\nu$  — кулоновское квантовое число, которые переходят по правилу непересечения термов [6, 7] в состояния, описываемые водородоподобной моделью  $(nlm)$ , где  $n$  — главное квантовое число,  $l$  — азимутальное квантовое число.

В настоящей работе методом СММ Л МС с использованием поляризованного по кругу излучения идентифицированы состояния как дискретного, так и квазидискретного примесного спектра. Недавно аналогичные измерения нами были выполнены для идентификации метастабильных акцепторных состояний в германии [5].

### 1. Эксперимент

Измерения выполнены на установке СММ Л МС, состоящей из СММ лазера с оптической накачкой излучением  $\text{CO}_2$  лазера и оптического криостата со сверхпроводящей катушкой.

Излучение СММ лазера с помощью зеркал фокусировалось на образец размером  $5 \times 4 \times 1$  мм, расположенный в центре сверхпроводящего соленоида. Спектр фотопроводимости (ФП) измерялся в геометрии Фарадея, когда магнитное поле направлялось параллельно волновому вектору СММ излучения и кристаллографическому направлению [111] образца. В дальнейшем мы рассматривали примесные состояния, связанные с  $A$ -долиной, вдоль которой направлено магнитное поле. Состояния, связанные с тремя  $B$ -долинами, вытянутыми под

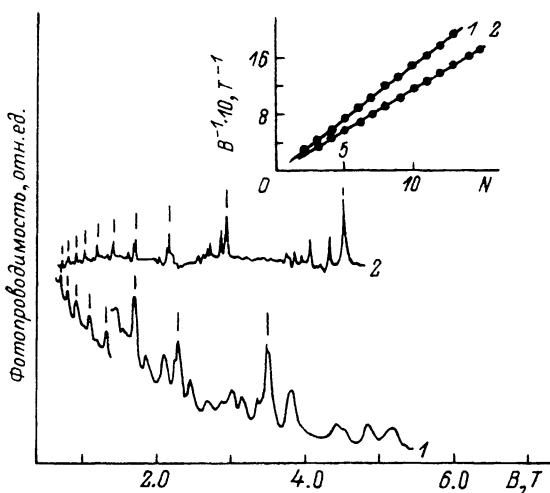


Рис. 1. Типичные спектры фотопроводимости образцов  $n$ -Ge, содержащие различные доминирующие доноры:

1 — P ( $N_d = N_a = 1.1 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$ ), 2 — Sb ( $N_d = N_a = 1.8 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ ).  $\lambda = 57 \text{ мкм}$ , линейная поляризация СММ излучения,  $T = 4.2 \text{ К}$ ,  $B \parallel [111]$ . На вставке — зависимость положения основных резонансов (отмечены стрелками) в обратном магнитном поле от номера уровня Ландау  $N$ .

одинаковым углом к магнитному полю и расположенные в гораздо больших магнитных полях, не рассматривались.

Для проведения измерений в циркулярно-поляризованном излучении использовались пластиинки  $\lambda/4$  из кристаллического кварца [8].

Так как основной причиной, ограничивающей разрешение в данной методике, является неоднородность магнитного поля на размере образца, использовались компенсирующие катушки, позволяющие получать высокую однородность магнитного поля ( $\Delta B/B < 5 \cdot 10^{-5}$  в 1 см<sup>3</sup>). Сигнал ФП записывался в режиме розвертки по магнитному полю по стандартной схеме синхронного детектирования при модуляции СММ излучения на частоте  $f = 500 \text{ Гц}$  механического прерывателя. Тянувшее поле не превышало величину примесного пробоя. Методика приготовления образцов и омических контактов к ним описана в [9]. Измерения проводились при  $T = 4.2 \text{ К}$ , для улучшения отношения сигнал/шум и получения спектра компенсированных примесей использовалась немодулированная межзонная подсветка (эффект оптической «перезарядки» примесей) [10].

## 2. Результаты и обсуждение

На рис. 1 показаны спектры ФП для двух образцов Ge, содержащих в качестве доминирующих примесей P и Sb, для длины волны СММ лазера  $\lambda = 57.0 \text{ мкм}$  в магнитном поле до 7 Т. Энергия кванта фотона существенно превышает энергию ионизации обеих примесей, и наблюдаемые резонансы в спектре обусловлены переходами электрона с основного на возбужденные состояния донора, расположенные под каждым уровнем Ландау начиная с  $N = 2$ , и последующей ионизацией примеси. Из этого рисунка видно, что расходящийся по магнитному полю линейчатый спектр периодичен по обратному магнитному полю (см. вставку рис. 1), величина периода связана с глубиной залегания примеси при  $B = 0$  [9]. Вблизи наиболее интенсивных пиков, связанных с определенным уровнем Ландау, наблюдаются резонансы, принадлежащие возбужденным состояниям того же уровня Ландау.

Доноры P. Примесный спектр доноров P в Ge достаточно хорошо известен. Исследования проводились как в отсутствие [11], так и при наличии магнитного

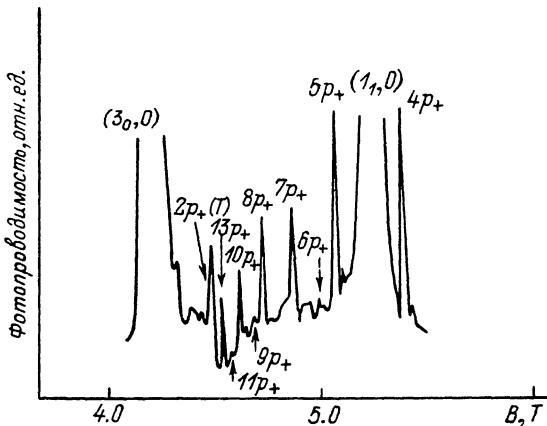


Рис. 2. Фрагмент спектра фотопроводимости образца  $p$ -Ge ( $N_a - N_d \approx 10^{10}$  см $^{-3}$ ) в присутствии межзонной подсветки, соответствующий переходам  $1s(A) - np_+$  мелкого донора Р.

$\lambda = 57$  мкм, линейная поляризация СММ излучения,  $T = 42$  К,  $B \parallel [111]$ . Резонанс, отмеченный  $2p_+(T)$ , соответствует переходу  $1s(T) - 2p_+$ .

поля [<sup>12</sup>], где наблюдались низколежащие  $2p_+$ ,  $3p_+$  возбужденные состояния [<sup>13, 14</sup>]. На рис. 2 показан фрагмент спектра ФП в магнитном поле для высоковозбужденных переходов под первым уровнем Ландау ( $1s - np_+$ ). Резонансы ( $3_0, 0$ ) и ( $1_1, 0$ ) соответствуют акцепторным переходам алюминия [<sup>5</sup>].

Так как основное состояние донора в Ge в результате долин-орбитального взаимодействия расщепляется на синглетное  $1s(A)$  и триплетные  $1s(T)$  (без учета спина), а величина этого расщепления ( $\Delta = 2.80$  мэВ) гораздо больше  $kT$ , то триплетные состояния не заселяются и наблюдаемые пики связаны с оптическими переходами из основного состояния  $1s(A)$ . Хотя известно, что под действием межзонной подсветки  $1s(T)$  состояния заселяются и наблюдается связанный с ними примесный спектр [<sup>15</sup>].

Идентификация резонансов (рис. 2) проводилась согласно [<sup>16</sup>], где теоретически рассчитаны спектр и силы осцилляторов высоковозбужденных донорных состояний в Ge в отсутствие магнитного поля. Была рассчитана серия  $np$  состояний вплоть до  $n = 17$ , причем спектр неводородоподобен, т. е. отклоняется от зависимости  $1/n^2$ , а силы осцилляторов убывают с ростом  $n$  немонотонным образом. Оба этих обстоятельства использовались при идентификации высоковозбужденных состояний фосфора. По-видимому, магнитное поле не должно приводить к существенному перераспределению сил осцилляторов, и относительные интенсивности резонансов на рис. 2 хорошо согласуются (за исключением пика  $13p_+$ ) с рассчитанными в [<sup>16</sup>].

Описываемые выше состояния относятся к дискретному примесному спектру ( $np_+$ ) в магнитном поле, имеющие также обозначения ( $11\nu$ ), где  $\nu$  четное.

На рис. 3 показана энергетическая схема примесных состояний в магнитном поле, взятая из работы [<sup>7</sup>]. Из этого рисунка видно, что под каждым уровнем Ландау возникает сложная картина состояний, часть которых относится к дискретному спектру (все состояния под нулевым уровнем Ландау и нижние — под остальными), а часть — к квазидискретному по приведенному выше критерию. Правила отбора для поляризованного по кругу излучения (геометрия Фарадея) в электродипольном приближении следующие:  $\Delta m = \pm 1$ ,  $\pi_i \pi_f = -1$ , где  $\pi_i, \pi_f$  — четность начального и конечного состояний соответственно. Четность определяется из выражения  $\pi = (-1)^{m+\nu}$  и для основного состояния равна  $\pi = +1$ . Таким образом, состояния под уровнями Ландау с  $N > 1$ , на которые осуществляются переходы с основного состояния донора, являются квазидискретными.

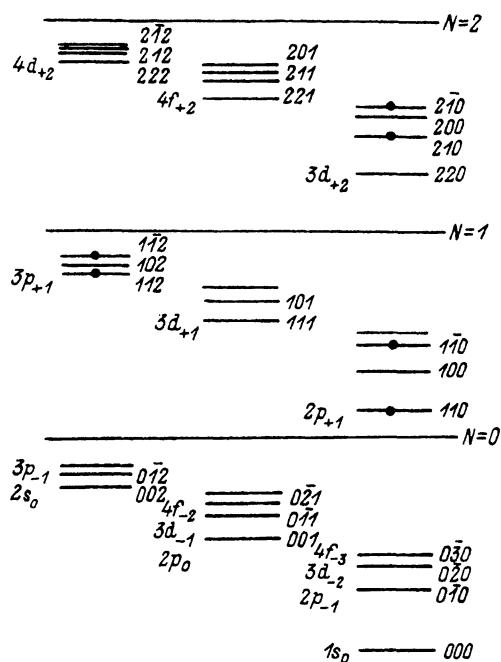
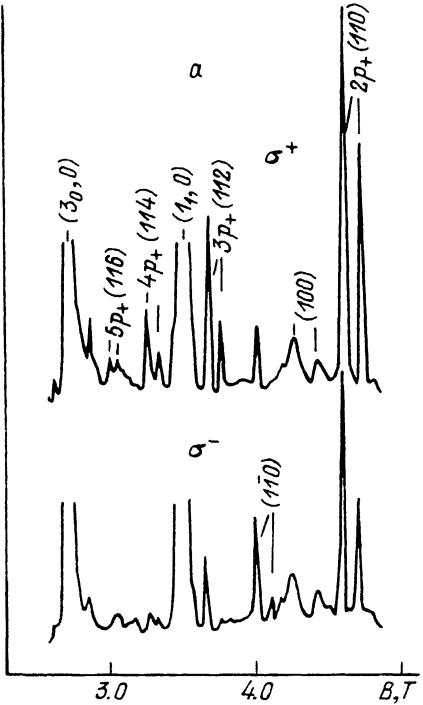


Рис. 3. Энергетическая схема примесных состояний в большом магнитном поле и правила отбора для круговой поляризации при переходах с основного состояния донора в электродипольном приближении [7].

На рис. 4 показаны спектры примесных переходов фосфора, принадлежащих уровням Ландау с  $N = 1$  (a) и  $N = 2$  (б), для правой ( $\sigma^+$ ) и левой ( $\sigma^-$ ) циркулярно-поляризованной волны СММ лазера. Из рис. 4, а видно, что, кроме известной дублетной структуры дискретных состояний  $2p_+$ ,  $3p_+$  и т. д., возникающей из-за различия  $g$ -факторов основного и возбужденного состояний [14], наблюдаются резонансы, имеющие обратную поляризационную зависимость и не зависящие от поляризации. Т. е. если пики серии  $pr^-$  подавляются при  $\sigma^-$ -поляризации, а возрастают при  $\sigma^+$ -поляризации, то дублетный пик, расположенный вблизи перехода на  $2p_+$  состояние и известный в литературе как «с»-пик [17], наоборот, возрастаает при  $\sigma^-$ -поляризации и подавляется при  $\sigma^+$ -поляризации. Поэтому мы идентифицировали его как переход на  $(110)$  состояние. Величина расщепления сравнима с расщеплением перехода на  $2p_+$  состояние, что свидетельствует о близости  $g$ -факторов возбужденных  $(110)$  и  $2p_+$  состояний. Неожиданным, и это отмечалось в [2] для n-GaAs, является то, что ширина линии этого метастабильного резонанса сравнима с шириной линии дискретного перехода. Это связано с тем, что невозможен развал возбужденного состояния на нижележащие уровни Ландау в силу закона сохранения момента [7]. Резонансы, расположенные между пиками дублетов  $(110)$  и  $(1\bar{1}0)$  состояний, не зависят от  $\sigma^\pm$ -поляризации, имеют также дублетную структуру, но по ширине значительно превосходят оба перечисленных резонанса и идентифицированы, согласно рис. 3, как  $(100)$  состояния. При более внимательном рассмотрении пик меньшей интенсивности имеет поляризационно зависящую часть, которая относится к комбинированному резонансу перехода  $1s-2p_+$ , недавно обнаруженному нами в [18].

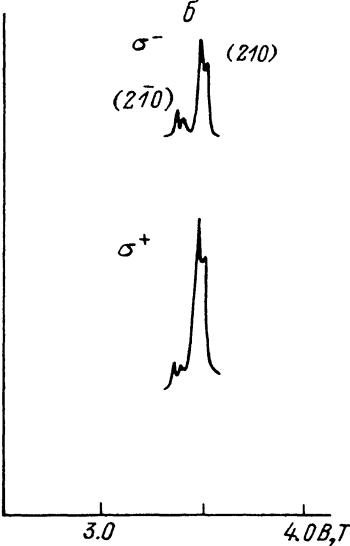
На рис. 4, б представлены спектры переходов на метастабильные состояния под уровнем Ландау с  $N = 2$ , из которых видно, что спиновый дублет резонансов сохраняется, так же как и для резонансов дискретного спектра. Наряду с

Фотопроводимость, отн.ед.



*a*

Фотопроводимость, отн.ед.



*b*

Рис. 4.

*a* — спектр фотопроводимости того же образца, что и на рис. 2, для правой ( $\sigma^+$ ) и левой ( $\sigma^-$ ) круговой поляризации СММ излучения, соответствующий переходам  $1s - np_+$ .  $\lambda = 70.5$  мкм,  $T = 4.2$  К,  $B \parallel [111]$ ; *b* — фрагмент спектра фотопроводимости, соответствующий переходам на примесные состояния фосфора под уровнем Ландау с номером 2;  $\lambda = 57$  мкм,  $T = 4.2$  К,  $B \parallel [111]$ .

резонансом (210) наблюдается и резонанс (210), идентифицированный по  $\sigma^\pm$ -поляризации. Аналогичные особенности наблюдались и для вышележащих уровней Ландау. Таким образом, под каждым уровнем Ландау для донора фосфора нами обнаружены по крайней мере два состояния, различающихся по проекции момента.

Доноры Sb. В отличие от доноров P долинное орбитальное расщепление основного состояния доноров Sb мало ( $\Delta = 0.32$  мэВ), и необходимо учитывать заселенность  $1s(T)$  состояния, а в магнитном поле снятие остаточного долинного и спинового вырождений. Ранее наблюдались основные переходы на  $2p_{\pm}$  и  $3p_{\pm}$  состояния доноров Sb в магнитном поле с учетом вышесказанного [<sup>14, 17</sup>].

На рис. 5 представлен спектр того же образца, что и на рис. 1 (2), содержащего Sb в качестве доминирующей примеси для правой и левой круговой поляризации СММ излучения ( $\lambda = 57$  мкм). Как отмечалось выше, из периодичности по обратному магнитному полю основного пика каждой серии (см. вставку рис. 1) следует, что все пики относятся только к возбужденным состояниям Sb. Из рис. 5 видно, что каждый второй пик (считая от основного) в серии резонансов, принадлежащих определенному уровню Ландау, по интенсивности подавляется для  $\sigma^+$ -поляризации и возрастает для  $\sigma^-$ -поляризации. Поляризационное поведение основных пиков каждой серии обратное, что позволяет сделать вывод о различной принадлежности по проекции момента этих двух возбужденных состояний под каждым уровнем Ландау.

В работе [<sup>14</sup>] было показано, что для доноров Sb вероятность переходов с  $1s(T)$  состояний в несколько раз превышает вероятность переходов с  $1s(A)$  во всем диапазоне магнитных полей. В свою очередь из шестикратно вырожденного

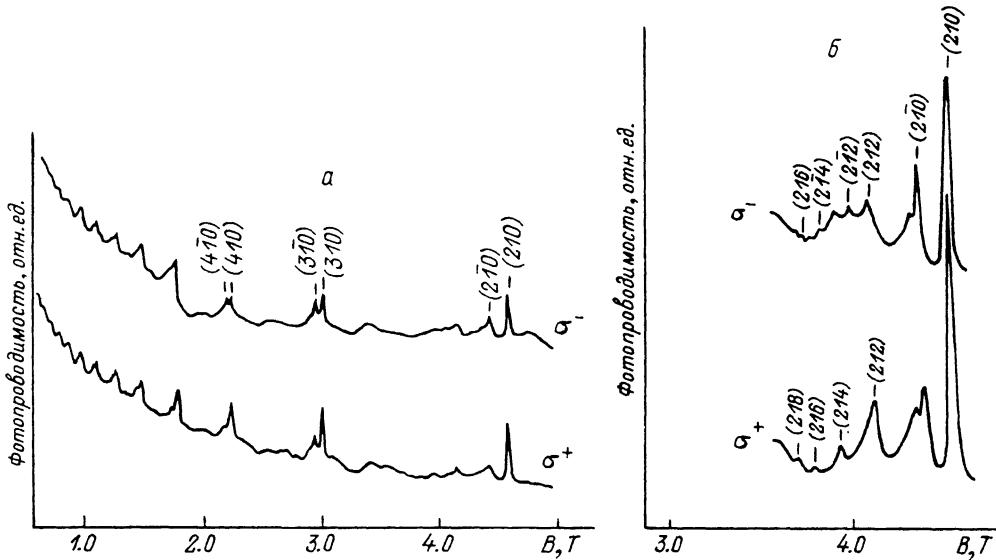


Рис. 5.

*a* — спектр фотопроводимости того же образца, что и на рис. 1 (кривая 2), для правой ( $\sigma^+$ ) и левой ( $\sigma^-$ ) круговой поляризации СММ излучения.  $\lambda = 57$  мкм,  $T = 4.2$  К,  $B \parallel [111]$ ; *б* — более подробный фрагмент спектра фотопроводимости, соответствующий переходу на примесные состояния Sb под уровень Ландау с номером 2.

$1s(T)$  в нулевом магнитном поле состояния (с учетом спина) переходы с двух состояний по правилам отбора запрещены, а еще с двух ( $E_2^+$  и  $E_2^-$ ) вероятность гораздо больше, чем с оставшихся ( $E_1'$  и  $E_1^-$ ) [<sup>14</sup>].

На рис. 5, *б* более подробно показан фрагмент спектра ФП, соответствующий переходам на квазидискретные состояния под вторым уровнем Ландау для циркулярно-поляризованной волны СММ излучения. Из этого рисунка видно, что для  $\sigma^+$ -поляризации интенсивность нечетных резонансов (начиная от основного) возрастает, а четных — падает. Для  $\sigma^-$ -поляризации наблюдается обратная картина. Исходя из этого, состояния под вторым уровнем Ландау идентифицированы нами как (21 $\nu$ ) и (21 $\nu$ ) квазидискретные состояния с  $\nu$  вплоть до 10 (четное).

Отсутствие спинового дублета для любого из переходов свидетельствует о том, что наблюдаемые резонансы связаны с переходами с  $1s(T)$  состояния Sb, для которого  $g$ -фактор сравним с  $g$ -фактором возбужденного состояния [<sup>14</sup>].

Таким образом, в работе обнаружен спектр дискретных высоковозбужденных состояний доноров Р вплоть до  $n = 13$ . Обнаружена немонотонная зависимость интенсивности пиков с ростом  $n$ , подтверждаемая теоретическими расчетами сил осциллятора для доноров в Ge [<sup>16</sup>].

Использование поляризационных измерений позволило идентифицировать известный в литературе « $c$ »-пик [<sup>17</sup>] как переход на возбужденное квазидискретное состояние (110). Аналогичные примесные состояния фосфора обнаружены и для вышележащих уровней Ландау.

Квазидискретные состояния обнаружены и для Sb при оптических переходах с  $1s(T)$  состояния, но в отличие от Р удалось идентифицировать состояния ( $N1\nu$ ) и ( $N1\nu$ ) при  $N = 2$  вплоть до  $\nu = 10$ , а интенсивности серии ( $N10$ ) сравнимы с ( $N10$ ).

В заключение авторы выражают благодарность Ш. М. Когану и С. К. Саввиных за полезные обсуждения.

## Список литературы

- [1] Wagner H. P., Prell W. // Sol. St. Comm. 1988. V. 66. N 4. P. 367—369.
- [2] Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Осугин А. В., Сейсян Р. П., Эфрос Ал. Л., Язева Т. В. // ФТП. 1988. Т. 22. № 8. С. 1416—1421.
- [3] Klarenbosch A., Klaassen T. O., Wenckebach W. Th. // J. Appl. Phys. 1990. V. 67. N 10. P. 6323—6328.
- [4] Jungwirt G., Kropf R., Roessler U., Prell W. // Sol. St. Comm. 1989. V. 72. N 1. P. 17—20.
- [5] Palkin A. M., Shegai O. A. // Phys. St. Sol. (b). 1991. V. 167. N 1.
- [6] Boyle W. S., Howard R. E. // J. Phys. Chem. Solids. 1961. V. 19. N 3/4. P. 181—188.
- [7] Simola J., Virtamo J. // J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. 1978. V. 11. N 19. P. 3309—3322.
- [8] Russell E., Bell E. E. // J. Optical Soc. Amer. 1967. V. 57. N 3. P. 341—348.
- [9] Неизвестный И. Г., Олзоев И. К., Палкин А. М., Шегай О. А. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 2. С. 570—572.
- [10] Kogan Sh. M., Lifshits T. M. // Phys. St. Sol. (a). 1977. V. 39. N 11. P. 11—39.
- [11] Seccomber S. D., Korn D. M. // Sol. St. Comm. 1972. V. 11. N 11. P. 1539—1545.
- [12] People R., Wolff P. A. // Phys. Rev. B. 1981. V. 24. N 8. P. 4634—4644.
- [13] Navarro H., Griffin J., Haller E. E. // J. Phys. C: Solid State Phys. 1988. V. 21. N 8. P. 1511—1520.
- [14] Аверкиев Н. С., Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Кропотов Г. И. // ЖЭТФ. 1982. Т. 83. № 4 (10). С. 1409—1417.
- [15] Rotsaert E., Clauws P., Vennik J., van Goethem L. // J. Appl. Phys. 1989. V. 65. N 2. P. 730—735.
- [16] Бейнихес И. Л., Коган Ш. М. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 44. № 1. С. 39—42; ЖЭТФ. 1987. Т. 93. № 1 (7). С. 285—301.
- [17] Horii K., Nisida Y. // J. Phys. Soc. Jap. 1971. V. 31. N 3. P. 783—791.
- [18] Палкин А. М., Шегай О. А. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 5. С. 1581—1582.

Институт физики полупроводников  
СО РАН  
Новосибирск

Поступило в Редакцию  
23 августа 1991 г.